

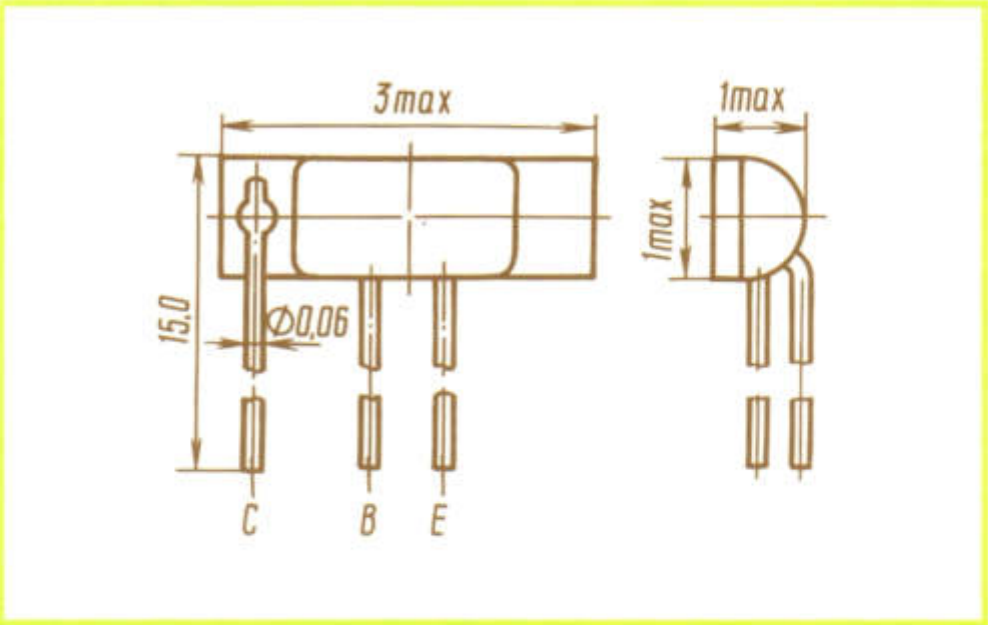
ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ СВЧ
MEDIUM-POWER MICROWAVE TRANSISTORS

KT625AM

Транзисторы KT625AM предназначены для работы в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках, имеющих герметичную защиту от действий солнечного света, влаги, соляного тумана, плесневых грибков, повышенного и пониженного атмосферного давления, используемых в устройствах широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The KT625AM transistors are designed for use in non-repairable hybrid circuits, micromodules, assemblies and subassemblies which are hermetically protected against the effects of sunlight, humidity, salt spray, mould fungi, high and low atmospheric pressure. The devices are intended for use in a wide range of applications.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT625AM	Режимы Conditions
1	2	3
$I_{CBO}, \mu A$	≤ 30	$U_{CB} = 60 V$
$I_{EBO}, \mu A$	≤ 100	$U_{EB} = 4 V$
h_{21E}	20–200	$U_{CE} = 1 V$ $I_C = 500 mA$
$ h_{21e} $	≥ 2	$U_{CE} = 10 V$ $I_C = 50 mA$ $f = 10^8 Hz$
$U_{CE sat}, V$	$\leq 1,2$	$I_B = 50 mA$ $I_C = 500 mA$
t_s, ns	≤ 60	$I_{B1} = I_{B2} = 50 mA$ $I_C = 500 mA$

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -45...+85^{\circ} C$
MAXIMUM RATINGS

$I_{C max}, A$	1
$I_{CM max}, (t_p \leq 5 \mu s; Q \geq 10), A$	1,3
$U_{CB max}, V$	60
$U_{EB max}, V$	4
$U_{CE max}, (R_{BE} = 5 k\Omega), V$	40
$P_C max., (t_{case} \leq 70^{\circ} C), W$	1
$t_j max., ^{\circ} C$	120

KT625AM

